

	<h2 style="color: #D9534F;">SIS888DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS888DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S
	Datenblätter:  SIS888DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 21850 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



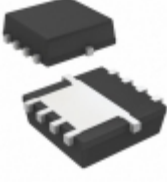

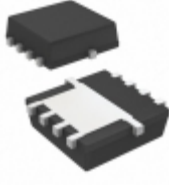



Spezifikationen

Teilenummer	SIS888DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21850 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S (3.3x3.3)
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Andere Namen	SIS888DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 20.2A (Tc) 52W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.2A (Tc)

SIS888DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS888DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS888DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS888DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS892ADN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS85C497NU SIS SIS QFP</p>	 <p>SIS892ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 28A PPAK 1212</p>	 <p>SIS888DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S</p>
 <p>SIS890DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8</p>	 <p>SIS892ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 28A PPAK 1212</p>	 <p>SIS890DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8</p>	 <p>SIS862DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 40A 1212</p>

SIS888DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIS888DN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS888DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS888DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS888DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS888DN-T1-GE3
SIS888DN-T1-GE3 Electronic	SIS888DN-T1-GE3 Komponenten	SIS888DN-T1-GE3 Verteiler	SIS888DN-T1-GE3 Bild	SIS888DN-T1-GE3 Aktie	SIS888DN-T1-GE3 Bild	SIS888DN-T1-GE3-Teil
SIS888DN-T1-GE3 Preis	SIS888DN-T1-GE3 Hersteller	SIS888DN-T1-GE3 garantiert	SIS888DN-T1-GE3 RFQ	SIS888DN-T1-GE3 Online bestellen	SIS888DN-T1-GE3 Inventar	
SIS888DN-T1-GE3 Neu	SIS888DN-T1-GE3 Original					

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited